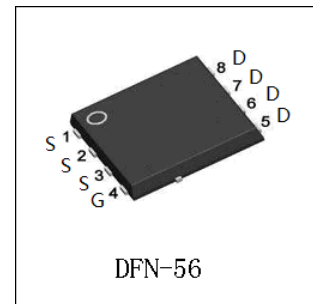


LYNM12N100DP (进口芯片) 型 N 沟道 MOS 场效应晶体管

特性

- 参照执行标准: QZJ840611, Q/RBJ1019QZ-2015
- 封装形式: DFN-56
- 开关速度快, 输入阻抗高, 驱动功耗小, 安全工作区宽, 温度稳定性好



极限参数

- 贮存温度 T_{stg} : $-55^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$
- 工作温度 T_{amb} : $-55^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$
- 焊接温度不超过 260°C , 焊接时间不超过 10 秒

器件型号	额定功率 P_D (W)	漏源电压 BV_{DSS} (V)	栅源电压 V_{GS} (V)	漏极电流 I_D (A)	导通电阻 R_{DS} ($m\Omega$)	热阻 $R_{th(j-c)}$ ($^{\circ}\text{C}/\text{W}$)
LYNM12N100DP	104 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	100	± 20	30 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	8	1.2

主要电特性 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小值	典型值	最大值	
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0\text{V}, I_D=250\mu\text{A}$	100	—	—	V
零栅压漏极电流	I_{DSS}	$V_{DS}=80\text{V}, V_{GS}=0\text{V}$	—	—	0.8	μA
正向栅极漏电流	I_{GSSF}	$V_{GS}=20\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$	—	—	100	nA
反向栅极漏电流	I_{GSSR}	$V_{GS}=-20\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$	—	—	-100	nA
开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu\text{A}$	2.0	—	4.0	V
导通电阻	$R_{DS(on)1}$	$V_{GS}=10\text{V}, I_D=13\text{A}$	—	—	18	$m\Omega$
	$R_{DS(on)2}$	$V_{GS}=6\text{V}, I_D=9.5\text{A}$	—	—	23.5	$m\Omega$
跨导	g_{FS}	$V_{DS}=10\text{V}, I_D=13\text{A}$	30	—	—	S
电容	C_{ISS}	$V_{DS}=50\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$	—	—	3000	pF
	C_{OSS}	$V_{DS}=50\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$	—	—	610	pF

